

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 84114847.1

51 Int. Cl.⁴: **H 03 K 17/08**
H 01 L 27/14

22 Anmeldetag: 06.12.84

30 Priorität: 08.12.83 DE 3344435

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 19.06.85 Patentblatt 85/25

64 Benannte Vertragsstaaten:
 CH DE FR GB IT LI

71 Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
 Berlin und München Wittelsbacherplatz 2
 D-8000 München 2(DE)

72 Erfinder: Tihanyi, Jenő, Dr. Ing.
 Windeckstrasse 1d
 D-8000 München 70(DE)

72 Erfinder: Fellinger, Christine, Ing.
 Gernersheimerstrasse 5
 D-8000 München 80(DE)

72 Erfinder: Leipold, Ludwig, Dipl.-Ing.
 Strassberger Strasse 125
 D-8000 München 40(DE)

54 Schaltungsanordnung zum Ansteuern eines Thyristors mit einem Fototransistor.

57 Die Kollektor-Emitterstrecke des Fototransistors (1) liegt zwischen einer (2) von zwei Wechselspannungsklemmen (2, 3) und dem Gateanschluß des Thyristors (10). Um ein Einschalten des unbeleuchteten Fototransistors (1) durch eine steile Spannungsflanke (du/dt -Belastung) zu verhindern, wird sein Basisstrom bei einer solchen Belastung über einen IGFET (4) vom Anreicherungstyp abgeleitet. Dieser IGFET (4) wird von einem als Stromquelle wirkenden IGFET (5) vom Verarmungstyp gesteuert, der zwischen Gate- und Sourceanschluß des IGFET (4) vom Anreicherungstyp liegt. Dem IGFET (5) vom Verarmungstyp ist ein Kondensator (6) in Reihe geschaltet; diese Reihenschaltung liegt zwischen den beiden Wechselspannungsklemmen (2, 3).

